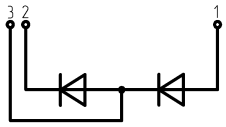
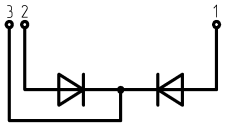
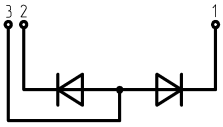
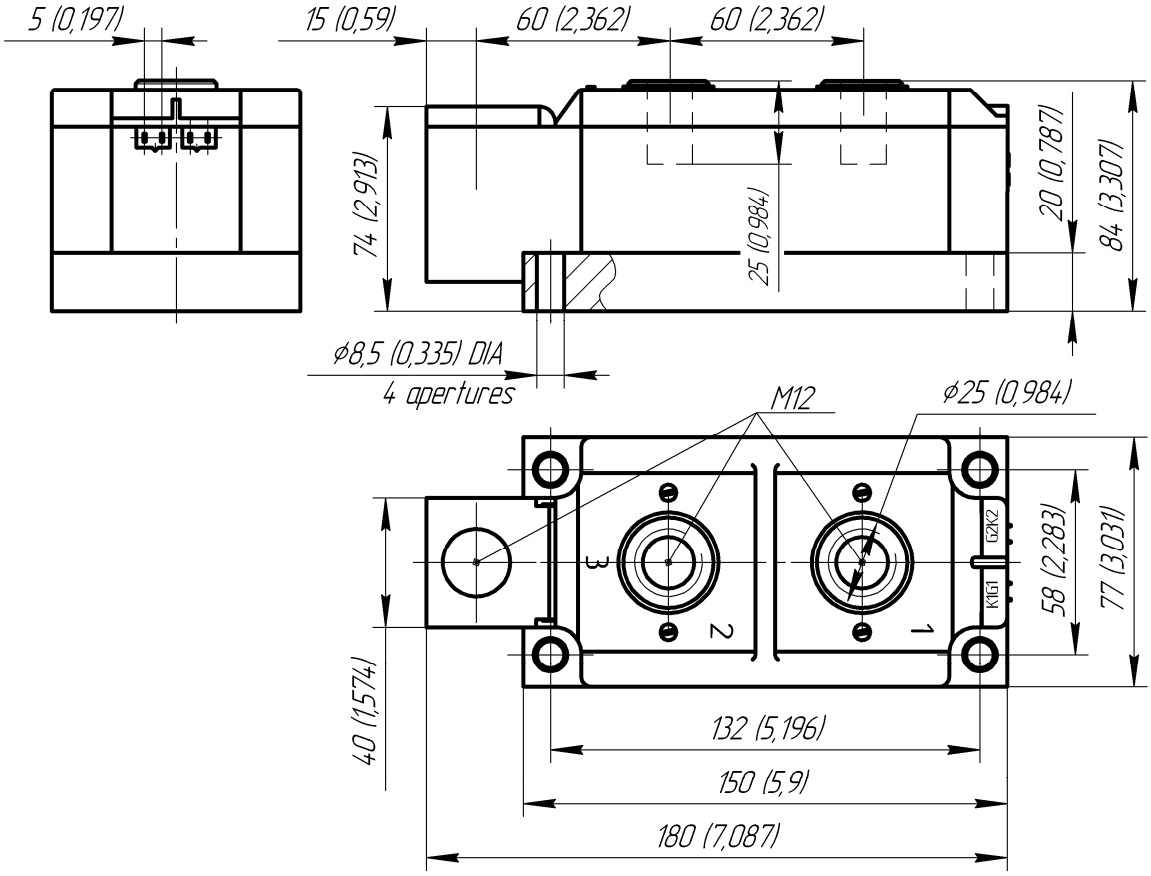
Изолированное основание
Корпус промышленного стандарта
Упрощенная механическая конструкция, быстрая сборка
Прижимная конструкция

Двухпозиционный Диодный Модуль МДх-1000-28-D

Средний прямой ток		I_{FAV}	1000 A		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U_{RRM}	2000 ÷ 2800 В		
U_{RRM}, В	2000	2200	2400	2600	2800
Класс по напряжению	20	22	24	26	28
T_j, °C	– 40 ÷ 150				

МД3		МД4		МД5	
					



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Средний прямой ток	А	1000 885	T_c=91 °C; T_c=100 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток	А	1570	T_c=91 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток	кА	32.0 37.0	$T_j=T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t_p=10 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
			34.0 39.0	$T_j=T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t_p=8.3 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
I^2t	Защитный фактор	$A^2c\cdot10^3$	5120 6845	$T_j=T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t_p=10 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
			4795 6310	$T_j=T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t_p=8.3 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	2000÷2800	$T_{j\,min}< T_j <T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	2100÷2900	$T_{j\,min}< T_j <T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	В	$0.75\cdot U_{RRM}$	$T_j=T_{j\,max}$;	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	°C	-40 ÷ 125		
T_j	Температура p-n перехода	°C	-40 ÷ 150		
Механические параметры					
a	Ускорение	м/с^2	50		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.38	T_j=25 °C; I_{FM}=3140 А
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.80	$T_j=T_{j\,max}$; $0.5\,\pi\,I_{FAV} < I_T < 1.5\,\pi\,I_{FAV}$
r_T	Динамическое сопротивление, макс	мОм	0.150	
Блокирующие характеристики				
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	70	$T_j=T_{j\,max}$; $U_R=U_{RRM}$
Тепловые характеристики				
R_{thjc}	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс			
	на модуль	°C/Вт	0.0250	180 эл. град. синус; 50 Гц (t_p=10 мс)
	на позицию	°C/Вт	0.0500	
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс			
	на модуль	°C/Вт	0.0080	
	на позицию	°C/Вт	0.0160	

Характеристики изоляции					
U_{ISOL}	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	t=1 мин
			3.60		t=1 с
Механические характеристики					
M_1	Момент затяжки основания (М8)[1)]	Нм	9.00	Допуск ± 15%	
M_2	Момент затяжки выводов (М12)[1)]	Нм	18.00	Допуск ± 15%	
w	Масса, тип	г	3500		

МАРКИРОВКА

МД	3	-	1000	-	28	-	D	-	У2
1	2		3		4		5		6

1. МД – Диодный Модуль
2. Схема включения
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Тип корпуса (М.х)
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2

ПРИМЕЧАНИЕ

[1)] Резьба должна быть смазана

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.